**Правила оформления трудов конференции**

Объем текста трудов конференции (тезисов) – 2 - 4 страницы, включая название, аннотацию и ключевые слова на английском языке, а также рисунки, таблицы и список литературы, формат листа А4, шрифт Times New Roman, размер – 12 pt, межстрочный интервал одинарный, все поля – 2 см, формат – «Книга», редактор Word.

В начале страницы печатается название работы. Ниже заглавия – фамилии и.о. авторов, затем наименование организации с указанием города и страны, электронный адрес ответственного за публикацию, аннотация, ключевые слова. Далее – текст трудов (тезисов) с рисунками, таблицами и пр., список литературы.

После списка литературы на английском языке название работы, ниже заглавия фамилии и.о. авторов, затем наименование организации с указанием города и страны, аннотация и ключевые слова.

Работа на конференцию подается вместе с экспертным заключение.

Пример оформления работы

**Исследование влияния параметров термообработки**

**на переходное сопротивление в системе Au–Ni–контактный слой QWIP-структуры**

*Трухачев А. В., Трухачева Н. С.*

АО «НПО «Орион», Москва, Россия

E-mail: \*\*\*@mail.ru

***Созданию контактов при разработке технологии электронных приборов всегда придается важное значение. В настоящей работе проведены исследования влияния параметров термообработки на переходное сопротивление в системе контактный слой QWIP-структуры (галлий арсенид) с напыленными на него металлами никель-золото.***

*Ключевые слова*: (QWIP-структура, контактный слой, термообработка, переходное сопротивление, контакты никель-золото, вольтамперная характеристика).

Контактные слои QWIP-структуры, представляют собой…

текст доклада

**Литература**

1. *Бурдуков Ю. М., Гашимзаде Ф. М., Гольдберг Ю. А. и др.* Арсенид галлия получение и свойства. – М.: Наука, 1973.

2.  *Неженцев А. В., Земляков В. Е., Егоркин В. И., Гармаш В. И.* Оптимизация режимов вжигания омических контактов к наногетероструктурам на основе арсенида галлия // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. 2015. Вып. 2–3 (236–237). С. 96–102.

3.  *Курочка С. П., Степушкин М. В., Борисов В. И.* Особенности создания омических контактов к гетероструктурам AlGaAs/GaAs с двумерным электронным газом // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2016. Т. 19. № 4. C. 271–278. Doi: 10.17073/1609-3577-2016-4-271-278

4.  *Трухачев А. В., Седнев М. В., Трухачева Н. С.* Применение индия для формирования низкоомных микроконтактов к контактным слоям арсенида галлия гетероэпитаксиальных QWIP-структур // Прикладная физика. 2018. № 5. С. 55.

**Study of the influence of heat treatment parameters on the transfer resistance in the Au-Ni-contact layer of the QWIP-structure**

*Trukhachev A. V., Trukhacheva N. S.*

Orion R&P Association, JSC, Moscow, Russia

***This paper contains the study of the influence of heat treatment parameters on the transfer resistance in the contact layer of the QWIP-structure (Ga-As) with Au–Ni–contacts.***

*Keywords*: QWIP-structure, contact layer, heat treatment, transfer resistance,
Ni–Au–contacts, voltage-current characteristic.